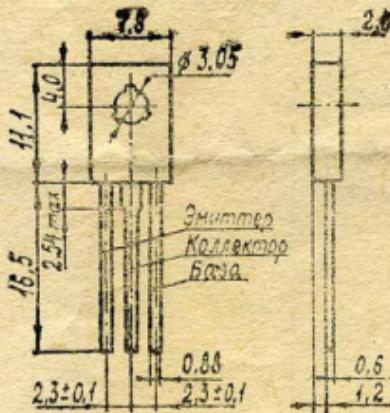


Э Т И К Е Т К А

Транзисторы КТ940А, КТ940Б, КТ940В

соответствуют ГОСТ 11630—844 техническим условиям
аA0.336.246 ТУ



Масса транзистора не более 0,8 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. приборов:

золото — 4,2591 г

Вывода транзисторов драгметаллами не покрываются.

Основные электрические параметры
при нормальных климатических условиях

Наименование параметра		КТ940А	КТ940Б	КТ940В
Обратный ток коллектора ИКБО, нА (при УКБ=250 В)	не более	50	—	—
(при УКБ=200 В)	не более	—	50	—
(при УКБ=100 В)	не более	—	—	50
Обратный ток эмиттера ИЭБО, нА (при УЭБ=3 В)	не более	50	50	50
Статический коэффициент передачи тока $h_{21\beta}$ (при ИЭ=30 мА, УКБ=10 В)	не менее	25	25	25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер УКЭнас, В (при ИК=30 мА, ИБ=6 мА)	не более	1	1	1
Модуль коэффициента передачи тока $ h_{21\beta} $ (при ИЭ=15 мА, УКБ=10 В, $f=30\text{МГц}$)	не менее	3	3	3
Емкость коллекторного перехода Ск, пФ (при УКБ=30 В, $f=10\text{ МГц}$)	не более	4,2	4,2	4,2
Тепловые параметры				

Место для штампа ОТК

ОТК9.3